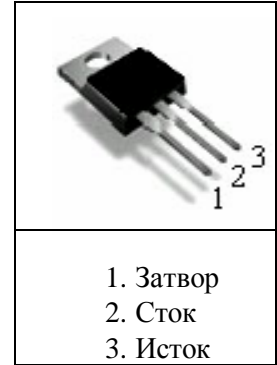


**КП796А,Б,В**

**МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ P-КАНАЛЬНЫЙ МОП ТРАНЗИСТОР**

АДБК 432140.950 ТУ

- \* Зарубежный аналог – **IRF9634**
- \* Изготавливается в корпусе КТ-28 (ТО-220).



**ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры	Обозначение	Един. измер.	Предельные значения		
			А	Б	В
Напряжение сток-исток	Uси max	В	-250	-300	-200
Напряжение затвор-исток	Uзи max	В	±20	±20	±20
Постоянный ток стока	Iс max	А	-4.1	-3,7	-4,1
Импульсный ток стока	Iс и max	А	-16	-15	-16
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	74	74	74
Прямой ток диода	Iпр. max	А	-4.1	-3,7	-4,1
Температура перехода	Tпер	°С	150	150	150

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°С)**

Параметры	Обозначение	Ед. изме- рения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Uзи пор	В	Iс=-250мкА, Uзи=Uси	-2.0	-4.0
Сопrotивление сток-исток в от- крытом состоянии	Rси отк	Ом	tи ≤300мкс. Q ≥50 Iс=-2.5А, Uзи=-10В		1,0 1,4
Остаточный ток стока	Iс ост	мкА	Uси=-250В, Uзи=0 Uси=-300В, Uзи=0 Uси=-200В, Uзи=0	-	-25 -25 -25
Ток утечки затвора	Iз ут	нА	Uзи=±20В, Uси=0	-	100
Крутизна ВАХ	S	А/В	tи ≤300мкс. Q ≥50 Uси=-20В, Iс=-4.1А Uси=-30В, Iс=-3.7А	2,2 2,2	
Прямое напряжение диода	Uпр	В	tи ≤300мкс. Q ≥50 Iс=-4.1А, Uзи=0 Iс=-3.7А		-6.5 -6,5
Время задержки включе- ния/выключения	tзд.вкл/выкл	нс	tи ≤300мкс. Q ≥50 Iс=-4.1А, Uси=-130В Rс=31Ом, Rг=12Ом Iс=-3.7А		12/34
Тепловое сопротивление пере- ход-корпус	Rt п-к	°С/Вт			1.7
Входная емкость	* C11и	пФ	Uзи=0, Uси=-25В, f=1МГц	-	1000
Выходная емкость	* C22и	пФ	Uзи=0, Uси=-25В, f=1МГц	-	250
Проходная емкость	* C12и	пФ	Uзи=0, Uси=-25В, f=1МГц	-	60

- Справочные параметры

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by); [www.transistor.by](http://www.transistor.by)